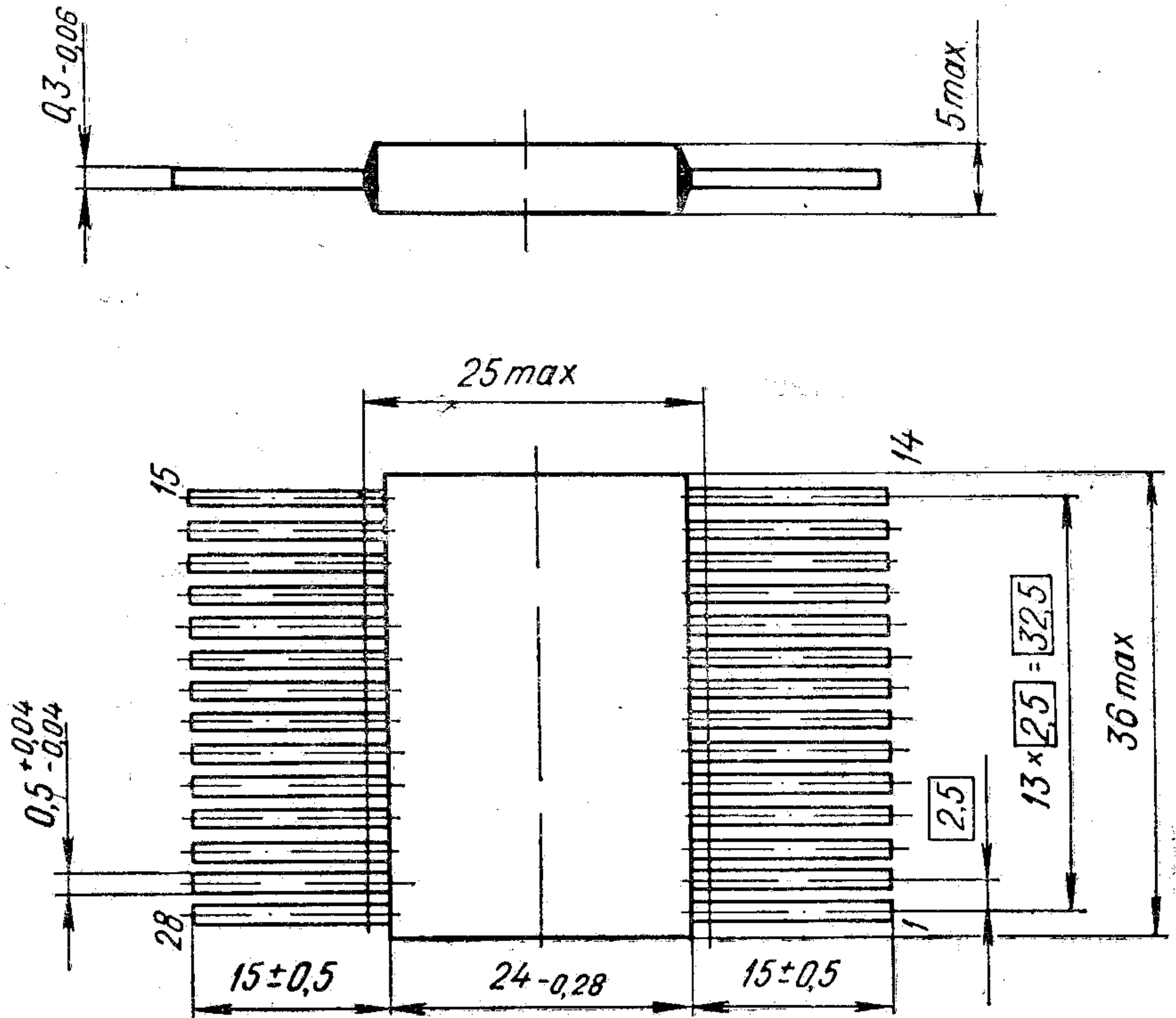


ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



Масса не более 7 г

Нумерация выводов микросхемы указана условно.

ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ

Синусоидальная вибрация:

диапазон частот, Гц	от 1 до 5000
амплитуда ускорения, $\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$ (g)	400 (40)

Механический удар одиночного действия:

пиковое ударное ускорение, $\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$ (g)	15 000 (1500)
длительность действия ударного ускорения, мс	от 0,1 до 2,0

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ 302

Общие данные

Механический удар многократного действия:	
пиковое ударное ускорение, $\text{м}\cdot\text{с}^{-2}$ (g)	1500 (150)
длительность действия ударного ускорения, мс	от 1 до 5
Линейное ускорение, $\text{м}\cdot\text{с}^{-2}$ (g)	5000 (500)
Акустический шум:	
диапазон частот, Гц	от 50 до 10 000
уровень звукового давления, дБ	170
Атмосферное пониженное давление, мм рт. ст. (Па):	
для микросхем 302НР1 (А—Е), 302НР2, 302НР3	5 (665)
» » 302НР4 (А—М)	10^{-6} ($1,3\cdot 10^{-4}$)
Атмосферное повышенное давление, атм	3
Повышенная температура среды, °С:	
для микросхем 302НР1 (А—Е), 302НР2, 302НР3	85
» » 302НР4 (А—М)	100
Пониженная температура среды, °С	минус 60
Изменения температуры среды, °С:	
для микросхем 302НР1 (А—Е), 302НР2, 302НР3	от минус 60 до +85
» » 302НР4 (А—М)	от минус 60 до +100
Иней, роса.	
Соляной туман.	
Среда, зараженная плесневыми грибами.	

НАДЕЖНОСТЬ

Минимальная наработка O , ч	25 000
Срок сохраняемости O , лет	25

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

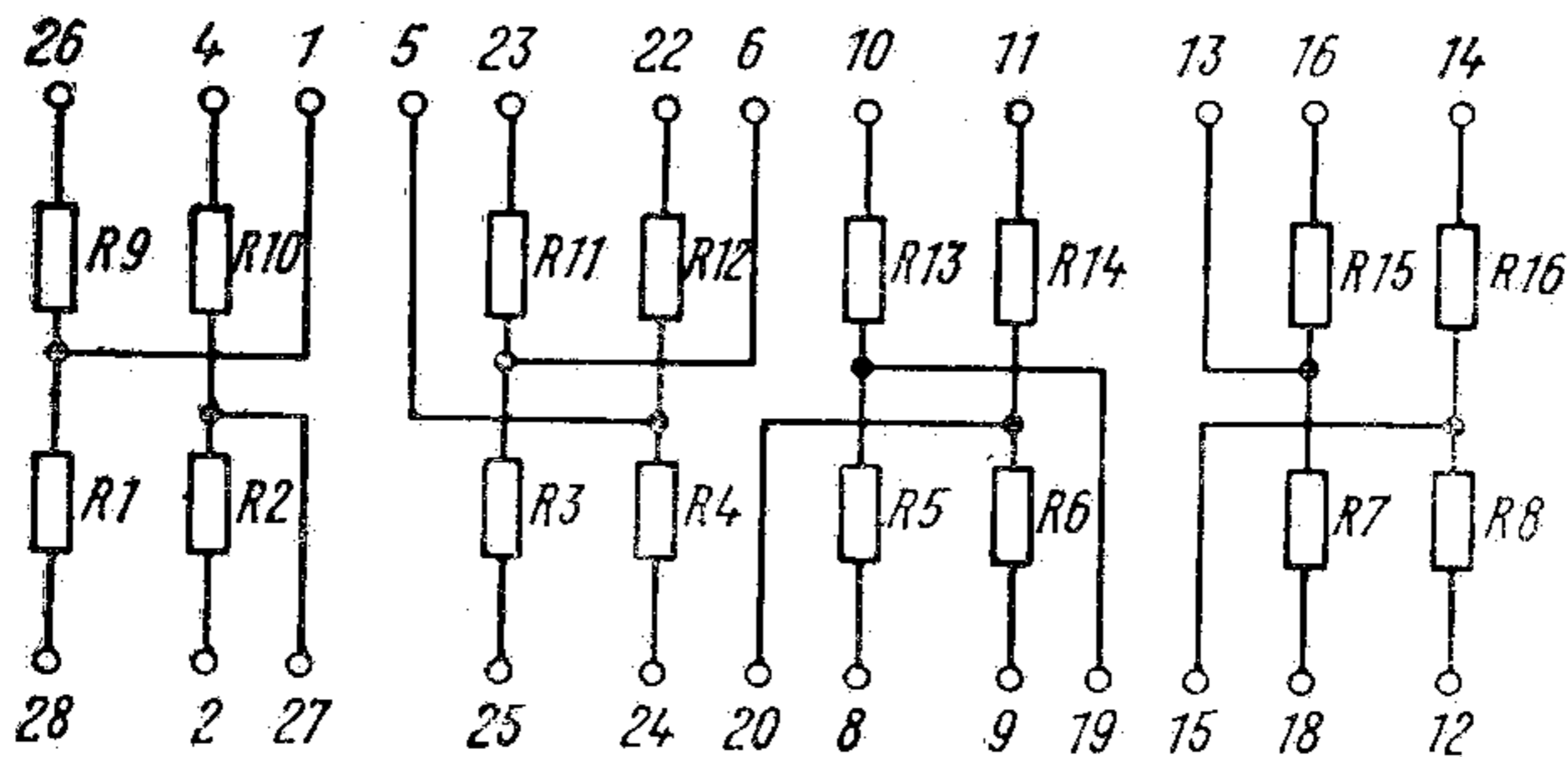
Микросхемы следует применять и эксплуатировать в соответствии с ОСТ В 11 073.041—82 и требованиями, изложенными ниже.

В пределах каждой группы и между группами резисторов микросхем допускаются внешние соединения, при этом мощность, рассеиваемая каждым резистором, не должна превышать мощности при основном включении.

Микросхемы устанавливаются на платы вплотную прилакировкой или приклеиванием. Допускается трехкратный монтаж и демонтаж микросхем.

○ В условиях и режимах, допускаемых ОТУ или ТУ.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА



Позици- онное обозна- чение	Точки измере- ния	Расчет- ный номинал, кОм	Предель- ное отклоне- ние, %	Позици- онное обозна- чение	Точки измере- ния	Расчет- ный номинал, кОм	Предель- ное отклоне- ние, %
R1	1—28	5	±10	R9	1—26	10	±10
R2	2—27	5		R10	4—27	10	
R3	6—25	5		R11	6—23	10	
R4	5—24	5		R12	5—22	10	
R5	8—19	5		R13	10—19	10	
R6	9—20	5		R14	11—20	10	
R7	13—18	5		R15	13—16	10	
R8	12—15	5		R16	14—15	10	

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

(при температуре 25°C)

Сопротивление резисторов R1—R8, кОм	от 4,106 до 5,894
Относительная погрешность коэффициентов деления при $U_{вх} \leq 15$ В, %, не более	±0,012
Сопротивление изоляции, МОм, не менее	100
Время установления переходных процессов, мкс, не более	0,1

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ
И РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Максимальное входное напряжение, В	36
Максимальная потребляемая мощность, мВт	500